4Pa127

β –(BEDT–TTF)₂PF₆、AsF₆およびSbF₆のESR

(総研大·分子研)O前田圭介、中村敏和

【序】

近年、有機導体の電荷分離状態の理解の進展により、金属-絶縁体転移の発現機構が 再検討されている。(BEDT-TTF)₂PF₆、AsF₆およびSbF₆は室温直下で金属-絶縁体転移を 起こす。その機構はこれまで2k_F CDW転移により説明されていたが、Nogamiらによる超格 子構造の解析により、電荷変調が非常に大きく、イオン性分子が強く二量化していることが 見出された¹⁾。さらに、PF₆塩の相転移については、Dingらによるラマンスペクトル測定により、 ドナー分子の電荷は0.2+と0.8+へ分離することが示された²⁾。これらの結果は、これまで CDWによって説明されてきた転移機構に疑問を投げかけるものである。我々はESRを用い てこれらの系の物性について詳細な測定を行い、絶縁体相の電子状態について検討して いる。本発表では、SQUIDによる磁化率測定の結果もあわせ低温電子状態について議論 を行う。

【方法】

本研究で用いたBEDT-TTF塩の単結晶は既報に従い作成した。PF₈塩およびAsF₈塩はそれぞれ[CH₃(CH₂)₃]₄NPF₆および[CH₃(CH₂)₃]₄NAsF₆を用いて、1,1,2-トリクロロエタン(TCE)溶液中での電解酸化により作成した。SbF₈塩はKSbF₆および18-6クラウンエーテルを用いてTCE溶液中での電解酸化により作成した。

ESR測定はBruker EPR-300Eを用いて行った。照射マイクロ波はX-バンドを用いた。キャビティは円筒型キャビティTE₀₁₁を用いた。

【結果】

1. (BEDT-TTF)₂PF₆ØESR

ESR積分強度から見積もったスピン磁化率は、293Kで相転移と思われる急激な減少を 示し、その挙動はSenadeeraらのSQUID測定³³から見積もったスピン磁化率の挙動とほぼー 致した。290-110Kの領域ではギャップ的ではなく直線的に減少し、110K以下でほぼ消失し た。





ESR線幅 Δ H_p, は、室温以上の領域においては温度の低下とともに減少し、金属状態で あることを支持している。磁化率の減少する293K近傍で Δ H_p,は急激に減少しており、スピ ン系のダイナミクスが大きく変化していることがわかる。260-180Kの領域で Δ H_p, がほとんど 変化しないのは、電子スピンが各サイトに局在しているためと考えられる。また、Δ H_p, は高 温領域ではc軸方向(積層方向)成分が最小であったが、180K以下ではa軸方向(分子の短 軸方向)成分が最小となり、異方性の変化が観測された。このような線幅の振る舞いは電 荷分離転移ではしばしば観測されるものである。

2. (BEDT-TTF)₂AsF₆ØESR

スピン磁化率は、295K付近で相転移と思われる、急激な減少が見られた。磁化率の温度依存性はPF。塩のものとよく似ている。

線幅 ΔH_{μ} は295K付近で急激に減少し、280-160Kの領域ではほとんど変化しなかった。 異方性についてはPF₆塩の場合と同様に、a軸およびc軸方向成分の間で、260Kで変化した。



これらの室温近傍の異常は電荷分離転移を強く示唆している。しかし、0型BEDT-TTF 塩や八面体アニオンを持つTMTTF系に見られる電荷分離転移と異なる点として、相転移温 度以下でも磁化率が大きく変化し、線幅も緩やかな変化を見せていることが挙げられる。ま た、転移温度がカウンターアニオンの種類には強く依存しないこともこの系に特徴的である。 以上の点から、この系の相転移は電子相関のみでなく、いくつかの要因が複合した結果で ある可能性がある。その物性については現在検討中であるが、さらに詳細なESRの解析に より解明できるのではないかと期待している。

(BEDT-TTF)₂SbF₆のESRは現在測定中であり、そのデータもあわせて当日議論を行う。

1) Y. Nogami and T. Mori, J. Phys. IV, 12, 233(2002)

2) Y. Ding, and H. Tajima, Syn. Met., 135, 599(2003).

3) G. K. R. Senadeera, T. Kawamoto, T. Mori, J. Yamamura, and T. Enoki, J. Phys. Soc. Jpn., 67, 4193(1998).